無制御での電流バランスと半導体素子の低耐圧化が可能な、再生可能 エネルギー向け高拡張性インタリーブ高昇圧コンバータの実機検証

小山 翔* 佐々木 優介 鵜野 将年(茨城大学)

Experimental Verification for Highly Extendable Interleaved High Step-Up Boost Converter with Automatic Current Balancing and Reduced Semiconductor Voltage Stresses for Renewable Energy Systems Kakeru Koyama^{*}, Yusuke Sasaki, Masatoshi Uno (Ibaraki University)

Boost converters with a high step-up conversion ratio, and a large input current capability are needed for low-voltage renewable energy resources, to be connected to the grid. This paper proposes a highly extendable interleaved high step-up boost converter with an automatic current balancing capability and reduced semiconductor voltage stresses, thanks to added capacitors. Step-up conversion ratios and input current capacities of the proposed converters can be arbitrarily enhanced by extending the number of stages and phases, respectively. Experimental results of a 350-W prototype demonstrated that in addition to reduced voltage stresses of semiconductors, step-up conversion ratios could be arbitrarily changed.

キーワード: 無制御での電流バランス,昇圧コンバータ,高拡張性,高昇圧コンバータ,インタリーブコンバータ, (Automatic current balancing, Boost converter, High extendibility, High step-up converter, Interleaved converter)

1. はじめに

近年,地球温暖化問題や化石燃料の枯渇に対する懸念から CO₂ 排出量の少ない代替エネルギーの研究開発が盛んに行われており,特に,燃料電池や太陽電池等の再生可能エネルギーが注目を浴びている。再生可能エネルギーを用いた系統連系システムを Fig.1 に示す。このシステムでは400 V 直流バスが敷設され,インバータを介して系統に接続される。一般的に,燃料電池や太陽電池の電圧は20~40 V と低いため,高昇圧コンバータを用いて昇圧する必要がある。しかし,昇圧比は10 以上の大きな値となるため,高昇圧コンバータには大電流入力容量が求められる。

大電流入力の用途に適した方式として、インタリーブコ ンバータ⁽¹⁾⁻⁽³⁾が提案されている。インタリーブコンバータは 複数のコンバータの多相並列化から構成され、複数の相に 電流を分配することで電流容量を増強できる。また、各相の 動作に位相差を持たせつつ、全ての相を同一周波数で駆動 することで、入出力部の電流リプルを低減できる。しかし、 実回路では素子定数やスイッチのデューティ d のばらつき に起因して、各相のインダクタ電流(相電流)のばらつきを 引き起こし、いずれかの相へと電流が集中することで素子 の電流ストレスが増加する。一般的なインタリーブコンバ ータでは、各相の d を微調整しゲインを均一化することで 相電流をバランスさせる⁽¹⁾。しかし、電流バランスには複数 の電流センサや制御回路が必要となるためシステムの複雑 化と高コスト化を招く⁽¹⁾。

システムの簡素化と低コスト化を目的として,無制御で 相電流バランスが可能なインタリーブコンバータが提案さ



Fig. 1. Typical grid-connected renewable energy system.

れている^{(2), (3)}。磁気結合を用いた方式⁽²⁾は無制御で電流バラ ンスが可能であるものの、複数の磁性素子を必要とするた め、回路の大型化が課題となる。一方、磁性素子と比較して コンデンサは100~1000倍程度のエネルギー密度を有するた め、コンデンサの電荷量保存則を用いた方式⁽³⁾では、回路の 小型化が可能となる。

ー般的な昇圧コンバータにおけるスイッチとダイオードの電圧ストレスは出力電圧 Vout となる。スイッチのオン抵抗は耐圧の 2.2~2.6 乗に比例することが知られており,高耐圧スイッチはオン抵抗が大きくなる傾向にある。また,ダイオードが高耐圧化すると順方向電圧も高くなる。よって,半導体素子の高耐圧化は電力変換効率を低下させる要因となる。

入力電圧 V_{in} に対し、一般的な昇圧コンバータの昇圧比は $V_{out}/V_{in} = 1/(1-d)$ となる。20~40 Vの電圧を400 Vのバス電圧 ヘ昇圧するには $d \ge 0.9$ と極端に大きい値で回路を動作させ る必要がある。極端なdでの動作は、入出力部の電流リプル、 半導体素子の電流ストレスならびに損失を増加させる。

極端な *d* での動作を回避しつつ高昇圧比を得ることを目 的として,カップルドインダクタやスイッチトキャパシタ を用いた高昇圧コンバータが提案されている^{(4),(5)}。カップ ルドインダクタ⁽⁴⁾は,インダクタの巻き数比を調整すること で任意に昇圧比を変更できる。しかし、回路の拡張に伴いその都度、インダクタを再設計する必要があるため拡張性に 乏しい⁽⁴⁾。一方、スイッチトキャパシタ⁽⁵⁾はコンデンサとダ イオードからなる倍電圧回路の追加により任意に昇圧比を 変更することができる。回路を再設計せずに拡張が可能と なるため、種々の電源に対し柔軟に対応できる。

本論文では、無制御での電流バランスと、スイッチとダイ オードの低耐圧化が可能な高拡張性インタリーブ高昇圧コ ンバータを提案する。提案方式はインタリーブ昇圧コンバ ータを基礎として、倍電圧回路を複数段接続することで導 出される。定格電力 350 W の試作回路を用いた実機検証に より、提案方式の有効性を実証したため報告する。

2. 提案するインタリーブ昇圧コンバータ

〈2・1〉 回路構成 提案するインタリーブ昇圧コンバータを Fig. 2 に示す。提案方式は複数の相と段から構成される。例として、Fig. 2(a)に示す 3 相 3 段 (3p-3s)構成では、A 相は添え字 A を有する素子から構成され、1 段目は倍電圧回路(DA1~DC1, CA1~CC1)で構成される。

3 相 3 段構成から段数と相数をそれぞれ拡張した構成を Fig. 2(b)と(c)に示す。提案方式では、段数と相数を拡張する ことで所望の昇圧比と電流容量を得ることができる。拡張 性については 2.3 節で詳細を説明する。

〈2・2〉 特徴 入出力の平滑コンデンサ Cin と Cout を除き、全てのコンデンサは Vin/(1-d)の電圧で充電される。よって、3相3段構成の昇圧比は 3/(1-d)となり、一般的な昇圧コンバータと比べて3倍の昇圧比を達成する。これにより、極端な d での動作を回避できるため、入出力部の電流リプル、半導体素子の電流ストレスならびに損失を低減できる。

ー般的な昇圧コンバータでは、スイッチとダイオードの 電圧ストレスが Vout となるのに対し、提案方式では CAI~Cc1 と CA2~Cc2 が一部の電圧を分担することで、電圧ストレスが 2Vout/3 以下となる。すなわち、半導体素子の低耐圧化が可能 となるため、提案方式では低オン抵抗のスイッチと順方向 電圧の低いダイオードを採用することができる。

スイッチの d や素子定数にばらつきが生じた場合でも, 提案方式では C_{A1} - C_{C1} と C_{A2} - C_{C2} の電荷量保存則により無 制御で相電流 i_{Lj} (j = A, B, C) がバランスする。よって,電 流バランスのための電流センサや制御回路が不要となり, システムの簡素化と低コスト化を達成する。

〈2・3〉 拡張性 提案方式は、段数を拡張することで 任意に昇圧比を変更できる。Fig. 2(b)に示す 3 相 4 段 (3p-4s)構成では、段数の増加により昇圧比は 4/(1-d)へと押し 上げられる。よって、M段に拡張した回路の昇圧比は M/(1-d) と一般化できる。更に、相数を拡張することで任意に電流容 量を変更できる。Fig. 2(c)に示す 4 相 3 段 (4p-3s)構成では、 3 相 3 段構成と比べて電流を分担する相数が多くなるため 電流容量の増強が可能である。

以上のように,提案方式では昇圧比を段数で,電流容量を 相数で調節することができる。よって,低電圧や大電流の特



(c)

Fig. 2. Proposed interleaved boost converters: (a) 3p-3s, (b) 3p-4s, (c) 4p-3s topologies.

徴を有する再生可能エネルギーに対し柔軟に対応できる。

3. 動作解析

本章では、3相3段構成を例に動作解析を行う。QA~Qcに 120°ずつ位相差を持たせつつ、d > 0.33で動作させることで インタリーブ動作と無制御での電流バランスを達成する。 なお、 $0.33 < d < 0.67 \ge 0.67 \le d < 1$ で動作が異なるが、紙面 上の都合により $0.67 \le d < 1$ の場合のみ動作解析を行う。

理論動作波形を Fig. 3 に、各モードの電流経路を Fig. 4 に それぞれ示す。 i_{LA} ~ i_{LC} は相電流、 v_Q はスイッチのドレイン-ソース間電圧、 v_{D1} ~ v_{D3} はダイオード電圧、 d_A ~ d_C は Q_A~Q_C の d をそれぞれ表し、 T_s はスイッチング周期を表す。なお、 C_{A1}~C_{C1} と C_{A2}~C_{C2} の容量は十分大きく、その電圧は一定で あると仮定する。また、解析の簡単化のため、全てのダイオ ードの電圧降下は無視できるものとする。

(3・1) 動作モードとコンデンサ電圧の導出 スイッ チの状態に基づき動作モードは4つに分けられる。

Mode 1 [Fig. 4(a)]: Q_A-Q_Cがすべてオンとなる。入力電圧 V_{in}から L_A-L_Cにエネルギーが蓄えられ, *i*_L-*i*_LCは増加する。



Fig. 3. Theoretical key waveforms.

なお、全てのダイオードには逆方向バイアスがかかるため 導通しない。この時、Coutが負荷へ電流を供給する。

Mode 2 [Fig. 4(b)]: Q_Aがオフ,Q_BとQcがオンとなる。L_A がエネルギーを放出し,*i*_Lは低下する。D_A,D_BそしてD_C は導通し,*i*_LはC_AとC_Aの充電,C_CとC_Cの放電を行う。

Mode 3 [Fig. 4(c)]: QB がオフ, QA とQc がオンとなる。LB がエネルギーを放出し, *iLB* は低下する。DA2, DB1 そして DC3 は導通し, *iLB* は CB1 と CB2の充電, CA1 と CA2の放電を行う。

Mode 4 [Fig. 4(d)]: Qc がオフ, QA と QB がオンとなる。Lc がエネルギーを放出し, *iLC* は低下する。DA3, DB2 そして DC1 が導通し, *iLC* は Cc1 と Cc2 の充電, CB1 と CB2 の放電を行う。

Q_A~Q_Cのうち1つがオフの時, C_{A1}~C_{C1}とC_{A2}~C_{C2}は充放 電を行う。Mode 2~4 において L_A~L_Cの電圧時間積を考慮す ると, C_{A1}~C_{C1}の電圧 V_{CA1}~V_{CC1}は次式のようになる。

$$V_{Cj1} = \frac{V_{in}}{1 - d_j}....(1)$$

また、CA2~Cc2 の電圧 VcA2~Vcc2 は LA~Lc の電圧時間積と VcA1~Vcc1 の和により導出される。例として、Mode 2 では LA の電圧時間積、Vcc1、VcA1、そして VcA2 の総和が 0 V と等し い関係から VcA2 が求められる。VcB2 と Vcc2 も同様の原理に より導出できる。従って、式(1)より VcA2~Vcc2 は、

$$V_{Cj2} = \frac{V_{in}}{1 - d_j} + V_{Cl1} - V_{Cj1} = \frac{V_{in}}{1 - d_l} \quad (l = C, A, B)....(2)$$

ここで, jがA, B, Cの時, 1はC, A, Bの順に対応する。 以上より, dにばらつきがなく d_A = d_B = dc = d であると仮 定すると,式(1),(2)をまとめて以下のように一般化できる。

$$V_{Cjn} = \frac{V_{in}}{1-d}$$
 (n = 1, 2)....(3)

〈3・2〉昇圧比 本節では、3相3段と3相4段構成の 昇圧比、そして M 段構成の昇圧比の一般式を導出する。全 ての素子は理想的であるものとし、d_A = d_B = dc = d とする。

提案方式の Vout は, La~Lc の電圧時間積と前節で導出した コンデンサ電圧の和により求められる。例として, Mode 2 に おける 3 相 3 段構成の Vout は, La の電圧時間積, Vcc1, そし て Vcc2 の合計値となる。Mode 3, 4 における Vout も同様の考



(d)

Fig. 4. Current flow directions of 3p-3s topology: (a) Mode 1, (b) Mode 2, (c) Mode 3, (d) Mode 4.

え方で導出できる。従って,式(3)より Vout は,

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - d_j} + V_{Cl1} + V_{Cl2} = \frac{3V_{in}}{1 - d} \dots (4)$$

よって、3相3段構成の昇圧比は一般的な昇圧コンバータ と比べて3倍となる。

また,段数の拡張に伴いコンデンサの直列接続数が増加 するため,昇圧比を上昇させることができる。3相4段構成 における Vout は段数の増加により次式のようになる。

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - d_j} + V_{Cl1} + V_{Cl2} + V_{Cl3} = \frac{4V_{in}}{1 - d}....(5)$$

ここで, V_{CA3}~V_{CC3}は C_{A3}~C_{C3}の電圧である。従って, M 段



Fig. 5. Photograph of 350-W prototype for 3p-4s topology.

構成の Vout は次式のように一般化できる。

 $V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - d_i} + V_{Cl1} + V_{Cl2} + \dots + V_{Cl(M-1)} = \frac{MV_{in}}{1 - d} \dots \dots (6)$

上式は提案方式が段数 *M*を調節することで任意に昇圧比 を変更できることを示している。

4. 実機検証

〈4・1〉 試作回路 コンデンサとダイオードを付け加えることで、最大4段まで拡張できる回路を試作した。例として、3相4段構成における定格電力350Wの試作回路をFig.5に示す。また、試作回路に使用した素子一覧表をTable.1に示す。実験条件はVin = 24 V, Vout = 400 V, スイッチング周波数は100 kHzとした。

〈4・2〉 動作波形 3相3段構成の定格負荷時におけるスイッチとダイオードの電圧波形,及び *iLA~iLC* の波形をFig. 6に示す。Fig. 3に示す理論波形との一致から試作回路の正常動作を確認した。また、*vQA~vQC*、*vDA3~vDC3*と *vDA1~vDC1*,*vDA2~vDC2*の電圧はそれぞれ *Voul/3*と 2*Voul/3*に低減された。

〈4・3〉 出力特性 3相3段と3相4段構成の提案方式,及び一般的な昇圧コンバータの出力特性をFig.7に示す。実験値と理論値は良い一致を示した。また,一般的な昇圧コンバータと比べて提案方式の昇圧比はそれぞれ3倍,4倍となった。よって,段数の拡張により任意に昇圧比を変更できることが示された。

5. まとめ

無制御での電流バランスと半導体素子の低耐圧化が可能 な高拡張性インタリーブ高昇圧コンバータを提案した。提 案方式は、コンデンサの電荷量保存則により無制御での電 流バランスが可能であり、且つ、コンデンサの電圧分担によ り半導体素子の電圧ストレスを低減できる。更に、相数と段 数の拡張により電流容量と昇圧比を任意に変更できる。

定格電力 350 W の試作回路を用いた実機検証により,半 導体素子の電圧ストレスを 2Vout/3 以下に低減可能であるこ とに加え,段数の拡張により昇圧比を任意に変更できるこ とを示した。

文 献

Table. 1.	Component v	alues of th	e prototype
-----------	-------------	-------------	-------------

Components	Value	
Switches	MOSFET, STB57N65M5, $R_{on} = 63 \text{ m}\Omega$	
$L_A \sim L_C$	Inductor, 68 µH	
$C_{A1} \sim C_{C3}$	Ceramic Capacitor, 2.2 µF×4	
$D_{A1} \sim D_{C3}$	Schottky Diode, SCS212AJ, $V_F = 1.35$ V	
$D_{A4} \sim D_{C4}$	Schottky Diode, STPS2200, $V_F = 0.58$ V	
C _{in}	Ceramic Capacitor, 10 µF×5	
Cout	Aluminum Electrolytic Capacitor, 100 µF	





Time [2 us/div.]



[2 us/div.]

Fig. 6. Measured key waveforms: (a) $v_{QA} \sim v_{QC}$, (b) $v_{DA1} \sim v_{DC1}$, (c) $v_{DA2} \sim v_{DC2}$, (d) $v_{DA3} \sim v_{DC3}$, (e) $i_{LA} \sim i_{LC}$.



Fig. 7. Experimental and theoretical step-up conversion ratios.

Current Sharing With Current Ripple Considered," IEEE Trans. Power Electron., Vol. 58, No. 7, pp. 2755–2771 (2011)

- (3) M. Uno, M. Inoue, Y. Sato, and H. Nagata: "Bidirectional Interleaved PWM Converter with High Voltage-Conversion Ratio and Automatic Current Balancing Capability for Single-Cell Battery Power System in Small Scientific Satellites," *Energies*, Vol. 11, No. 10, pp. 1–12 (2018)
- H. Liu, Z. Zhou, K. Liu, P. C. Loh, W. Wang, D. Xu, and F. Blaabjerg: "A Family of High Step-Up Coupled-Inductor Impedance-Source Inverters With Reduced Switching Spikes," *IEEE Trans. Power Electron.*, Vol. 33, No. 11, pp. 9116–9121 (2018)
- (5) J. Chen, D. Sha, Y. Yan, B. Liu, and X. Liao, "Cascaded High Voltage Conversion Ratio Bidirectional Nonisolated DC-DC Converter With Variable Switching Frequency," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 33, no. 2, pp. 1399–1409 (2018)

H. C. Chen, C. Y. Lu, and U. S. Rout: "Decoupled Master-Slave Current Balancing Control for Three-Phase Interleaved Boost Converters," *IEEE Trans. Power Electron.*, Vol. 33, No. 5, pp. 3683–3687 (2018)

⁽²⁾ K. I. Hwu, and Y. H. Chen: "Applying Differential-Mode Transformer to